# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-228697

(43) Date of publication of application: 29.08,1995

(51)Int.Cl.

CO8G 73/10 CO8L 79/08 CO9J 7/02 CO9J 7/02 CO9J179/08

(21)Application number: 06-018496

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

15.02.1994

(72)Inventor: TAKEDA SHINJI

YUSA MASAMI MASUKO TAKASHI MIYADERA YASUO

## (54) ADHESIVE FILM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an adhesive film containing a polyimide resin synthesized by reacting tetracarboxylic acid dianhydride with a diamine, capable of performing a heat treatment in adhesion at low temperatures in the same manner as silver paste and useful as an adhesive material for adhesion between IC or LSI and a lead frame.

CONSTITUTION: This film contains a polyimide resin synthesized by reacting tetracarboxylic acid dianhydrides containing ≥70mol% the tetracarboxylic acid § dianhydrides of the formula [(n) is 2 to 20] with a diamine (e.g. 1,2- diaminoethane or p-phenylenediamine).

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平7-228697

(43)公開日 平成7年(1995)8月29日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 8 G 73/10	識別記号 NTF	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
COSL 79/08	LRC				
C09J 7/02	JHL				
	JKD				
179/08	JGE				
			<b>永龍査審</b>	未請求 請求項の数2 〇	L (全 10 頁)
(21)出願番号	特顯平6-18496		(71) 出顧人	000004455	
				日立化成工業株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)2月	15日		東京都新宿区西新宿2丁目	1番1号
			(72)発明者	武田 信司	
				茨城県つくば市和台48番	日立化成工業株
			(70) % ntl +s	式会社筑波開発研究所内	
			(72)発明者		
				茨城県つくは市和台48番	日立化成工業株
			(70) \$\text{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	式会社筑波開発研究所内	
			(72)発明者	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				茨城県つくば市和台48番	日立化成工業株
			(7.4) (Dame 1	式会社筑波開発研究所内	
			(14)10建入	弁理士 若林 邦彦	m shows as a
					最終頁に続く

# (54)【発明の名称】 接着フィルム

### (57)【要約】

【目的】 接着時の熱処理を従来の銀ペーストと同じように比較的低温で行うことのできる、ダイボント用接着フィルムを提供する。

【構成】 ① (A) 下記の式 (I) (式 (I) 中、nは 2~20の整数を示す。〕で表されるテトラカルボン酸二無水物、の含量が、全テトラカルボン酸二無水物の7\*

- \* 0 モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミド樹脂を含有してなる接着フィルム。
  - ②上記ポリイミド樹脂に加え、熱硬化性樹脂; 0. 1~200重量部、を含有してなる接着フィルム。 【化1】

【特許請求の範囲】 【請求項1】化1の式(1) \* [化1] : :

(ただし、n=2~20の整数を示す。)で表されるテトラカルボン酸二無水物、の含量が全テトラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミド樹脂を含有してなる接着フィルム。

1

【請求項2】(A)式(I)のテトラカルボン酸二無水物、の含量が全テトラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミド樹脂;

(B) 熱硬化性樹脂、を含有してなる接着フィルム。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICやLSIとリードフレームの接合材料、すなわちダイボンディング用材料 20として用いられる接着フィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ICやLSIとリードフレームの接合にはAu-Si共晶合金、半田あるいは銀ペースト等が用いられている。Au-Si共晶合金は、耐熱性及び耐湿性は高いが、弾性率が大きいため大型チップへ適用した場合に割れやすいほか、高価である難点がある。半田は安価であるものの、耐熱性が劣り、更に弾性率はAu-Si共晶合金と同様に高く、大型チップへ適用が困難である。いっぽう、銀ペーストは安価で、耐湿性が30高く、弾性率も上記3者の中では最も低く、350℃の熱圧着型ワイヤボンダーに適用できる耐熱性も有するので、現在ハICやLSIとリードフレームの接着用材料の主流である。しかし、近年ICやLSIの高集積化が※

※進み、それに伴ってチップが大型化しているなかで、I CやLSIとリードフレームを銀ペーストで接合しよう とする場合、銀ペーストをチップ全面に広げ塗布するに は困難を伴う。

【0003】マイクロエレクトロニック マニュファクチャリング アンド テスティング(MICROELECTRONIC MANUFACTURING AND TESTING 1985年10月)に、導電性フィラーを熱可塑性樹脂に充填したダイボンド用の接着フィルムが報告された。これは熱可塑性樹脂の融点付近まで温度を上げ、加圧接着するものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記雑誌で報告された接着フィルムは、融点が低い熱可塑性樹脂を選んで用いると接着温度を低くすることができ、リードフレームの酸化等、チップに与えるダメージは少なくてすむ。しかし、熱時接着力が低いのでダイボンド後の熱処理、例えばワイヤボンド、封止工程等に耐えられない。そのような熱処理に耐えられるように融点の高い熱可塑性樹脂を用いると、接着温度が高くなり、リードフレームの酸化等のダメージを受ける問題がある。本発明は、ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと同じように比較的低温で行うことができ、かつ、熱時接着力の高いダイボント用接着フィルムを提供することを目的としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】

① 本発明の接着フィルムは、化2の式(I)【化2】

(ただし、n=2~20の整数を示す。)で表されるテトラカルボン酸二無水物、の含量が、全テトラカルボン 40酸二無水物に対して70モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られる、ポリイミド樹脂を含有してなる接着フィルムである。

【0006】また本発明の接着フィルムは、次のようにして製造する。

(1)式(I)のテトラカルボン酸二無水物、の含量が全テトラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミド樹脂(A);100重量部、を有機溶媒に溶解し、

(2) ベースフィルム上に塗布し、加熱する。

40 【0007】上記のポリイミド樹脂の原料として用いられる、式(I)のテトラカルボン酸二無水物としては、nが2~5のとき、1,2-(エチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,4-(テトラメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,4-(テトラメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,5-(ペンタメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、nが6~20のとき、1,6-(ヘキサメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,7-(ヘプタメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,8-(オクタメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,8-(オクタメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,8-(オクタメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)、1,9-(ノ

ナメチレン) ビス (トリメリテート二無水物)、1,10-(デカメチレン) ビス (トリメリテート二無水物)、1,12-(ドデカメチレン) ビス (トリメリテート二無水物)、1,16-(ヘキサデカメチレン) ビストリメリテート二無水物、1,18-(オクタデカメチレン) ビス (トリメリテート二無水物)、等があり、これら2種以上を併用してもよい。

【0008】上記テトラカルボン酸二無水物は、無水トリメリット酸モノクロライド及び対応するジオールから合成することができる。また、全テトラカルボン酸二無 10水物に対して上記テトラカルボン酸二無水物の含まれる量は、70モル%以上である。70モル%未満であると、接着フィルムの接着時の温度が高くなり好ましくない。

【0009】式(1)のテトラカルボン酸二無水物と共 に使用できるテトラカルボン酸二無水物としては、例え ば、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'-ジ フェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2',3, 3'ージフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水 20 物、2,2ービス(2,3ージカルボキシフェニル)プ ロパン二無水物、1,1-ビス(2,3-ジカルボキシ フェニル) エタン二無水物、1,1-ビス(3,4-ジ カルボキシフェニル)エタン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル) メタン二無水物、ビス (3, 4 ージカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水物、3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物、ビ ス(3、4ージカルボキシフェニル)エーテル二無水 物、ベンゼンー1, 2, 3, 4ーテトラカルボン酸二無 30 水物、3,4,3',4'ーベンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物、2,3,2',3-ベンゾフェノンテ トラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'ーベンゾ フェノンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7 ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,4, 5ーナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、1,4, 5.8ーナフタレンーテトラカルボン酸二無水物、 【0010】2,6ージクロルナフタレン-1,4, 5,8-テトラカルボン酸二無水物、2,7-ジクロル 40 ナフタレンー1、4、5、8ーテトラカルボン酸二無水 物、2、3、6、7ーテトラクロルナフタレンー1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、フエナンスレ ンー1,8,9,10ーテトラカルボン酸二無水物、ピ ラジンー2,3,5,6ーテトラカルボン酸二無水物、 チオフエンー2、3、4、5ーテトラカルボン酸二無水

物、2,3,3',4'-ビフェニルテトラカルボン酸

二無水物、3,4,3′, 4′ービフェニルテトラカル

ボン酸二無水物、2,3,2',3'-ビフェニルテト

ラカルボン酸二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフ 50

ェニル)ジメチルシラン二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)メチルフェニルシラン二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)ジフェニルシランニ無水物、1,4ービス(3,4ージカルボキシフェニルジメチルシリル)ベンゼン二無水物、1,3ービス(3,4ージカルボキシフェニル)-1,1,3,3ーテトラメチルジシクロヘキサン二無水物、pーフェニレンビス(トリメリテート無水物)、

【0011】エチレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4ープタンテトラカルボン酸二無水物、デカヒ ドロナフタレンー1, 4, 5, 8ーテトラカルボン酸二 無水物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキサヒドロナフタレンー1, 2, 5, 6ーテトラカル ボン酸二無水物、シクロペンタン-1, 2, 3, 4-テ トラカルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3,4,5 ーテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロ ブタンテトラカルボン酸二無水物、ビス(エキソービシ クロ〔2, 2, 1〕 ヘプタン-2, 3-ジカルボン酸二 無水物)スルホン、ビシクロー(2,2,2)ーオクト (7) -エン2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水 物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)へ キサフルオロプロパン二無水物、2,2-ビス〔4-(3, 4-ジカルボキシフェノキシ) フェニル] ヘキサ フルオロプロパン二無水物、4,4'ービス(3,4-ジカルボキシフェノキシ) ジフェニルスルフイド二無水 物、1,4ービス(2ーヒドロキシヘキサフルオロイソ プロピル) ベンゼンビス (トリメリット酸二無水物)、 1, 3-ビス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロ ピル) ベンゼンビス (トリメリット酸二無水物)、5-(2, 5ージオキソテトラヒドロフリル) ー3ーメチル -3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸二無水 物、テトラヒドロフランー2、3、4、5ーテトラカル ボン酸二無水物等があり、2種類以上を混合して用いて もよい。

【0012】本発明で使用されるジアミンとしては、 1. 2 - ジアミノエタン、1, 3 - ジアミノプロパン、 1, 4ージアミノブタン、1, 5ージアミノペンタン、 1, 6 - ジアミノヘキサン、1, 7 - ジアミノヘプタ ン、1、8ージアミノオクタン、1、9ージアミノノナ ン、1,10-ジアミノデカン、1,11-ジアミノウ ンデカン、1,12-ジアミノドデカン等の脂肪族ジア ミン、oーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミ ン、p-フェニレンジアミン、3,3'-ジアミノジフ ェニルエーテル、3, 4'ージアミノジフェニルエーテ ル、4、4′ージアミノジフェニルエーテル、3、3′ ージアミノジフェニルメタン、3,4'ージアミノジフ エニルメタン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、 3, 3' ージアミノジフェニルジフルオロメタン、3. 4'ージアミノジフェニルジフルオロメタン、4、4' ージアミノジフェニルジフルオロメタン、3,3'ージ

20

40

アミノジフェニルスルホン、3, 4′ージアミノジフェ ニルスルホン、4,4'ージアミノジフェニルスルホ ン、3, 3' ージアミノジフェニルスルフイド、3, 4' ージアミノジフェニルスルフイド、4, 4' ージア ミノジフェニルスルフイド、

【0013】3、3′ージアミノジフェニルケトン、 3. 4'ージアミノジフェニルケトン、4,4'ージア ミノジフェニルケトン、2,2ービス(3ーアミノフェ ニル)プロパン、2,2'-(3,4'-ジアミノジフ ェニル)プロパン、2,2ービス(4ーアミノフェニ ル) プロパン、2, 2-ビス(3-アミノフェニル)へ キサフルオロプロパン、2,2-(3,4'-ジアミノ ジフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2、2-ビス (4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、1, 3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1.4-ビス(3ーアミノフェノキシ)ベンゼン、1,4ービス 4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン)) ビスア ニリン、3, 4'-(1, 4ーフェニレンビス(1ーメ チルエチリデン)) ビスアニリン、4,4'-(1,4 **ーフェニレンビス(1 ーメチルエチリデン))ビスアニ** リン、2、2ービス(4ー(3ーアミノフェノキシ)フ ェニル)プロパン、2,2ービス(4-(4-アミノフ ェノキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、2、2-ビス(4-(4-アミノフエノキシ) フエニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルフイド、ビス(4-(4-アミノフェノキシ) フェニル) スルフイド、ビス (4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン、 ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)スルホ ン等の芳香族ジアミンを挙げることができる。

【0014】テトラカルボン酸二無水物とジアミンの縮 合反応は、有機溶媒中で行う。この場合、テトラカルボ ン酸二無水物とジアミンは等モル又はほぼ等モルで用い るのが好ましく、各成分の添加順序は任意である。用い る有機溶媒としては、ジメチルアセトアミド、ジメチル ホルムアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチル スルホキシド、ヘキサメチルホスホリルアミド、mーク レゾール、oークロルフェノール等がある。

【0015】反応温度は80℃以下、好ましくは0~5 0℃である。反応が進行するにつれ反応液の粘度が徐々 に上昇する。この場合、ポリイミドの前駆体であるポリ アミド酸が生成する。

【0016】ポリイミドは、上記反応物(ポリアミド 酸)を脱水閉環させて得ることができる。脱水閉環は1 20℃~250℃で熱処理する方法や化学的方法を用い て行うことができる。120℃~250℃で熱処理する 方法の場合、脱水反応で生じる水を系外に除去しながら 行うことが好ましい。この際、ベンゼン、トルエン、キ 50 (1)式(I)のテトラカルボン酸二無水物、の含量が、

シレン等を用いて水を共沸除去してもよい。なお、本発 明においてポリイミド樹脂とは、ポリイミド及びその前 駆体を総称する。ポリイミドの前駆体には、ポリアミド 酸のほか、ポリアミド酸が部分的にイミド化したものが ある。

【0017】化学的方法で脱水閉環させる場合は、閉環 剤として無水酢酸、無水プロピオン酸、無水安息香酸の 酸無水物、ジシクロヘキシルカルボジイミド等のカルボ ジイミド化合物等を用いる。このとき必要に応じてピリ ジン、イソキノリン、トリメチルアミン、アミノピリジ ン、イミダゾール等の閉環触媒を用いてもよい。閉環剤 又は閉環触媒は、テトラカルボン酸二無水物 1 モルに対 し、それぞれ1~8モルの範囲で使用するのが好まし

【0018】また、接着力を向上させるため、ポリイミ ド樹脂にシランカップリング剤、チタン系カップリング 剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、シリ コーン系添加剤等を適宜加えてもよい。

【0019】本発明の接着フィルムの製造は、以下のよ うにする。まずポリイミド樹脂を有機溶媒に溶解する。 ここで用いられる有機溶媒は、均一に溶解又は混練でき るものであれば特に制限はなく、そのようなものとして は例えば、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミ ド、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ジ エチレングリコールジメチルエーテル、トルエン、ベン ゼン、キシレン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフ ラン、エチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテー ト、ブチルセロソルブ、ジオキサン等が挙げられる。次 いで、必要に応じ添加剤を加え、混合する

【0020】こうして得たワニスを、例えばポリエステ ル製シート等のベースフィルム上に均一に塗布し、使用 した溶媒が充分に揮散する条件、すなわち、おおむね6 0~200℃の温度で、0.1~30分間加熱し、接着 フィルムとし、通常、使用時にベースフィルムを除去し て接着に用いる。

【0021】② 本発明の接着フィルムは、(A)前記 式(I)のテトラカルボン酸二無水物、の含量が、全テ トラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテトラ カルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られる ポリイミド樹脂; 100重量部に対し、(B)熱硬化性 樹脂; 0.1~200重量部、を含有してなる接着フィ ルムでもある。

【0022】ここで、熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂、 フェノール樹脂及び硬化促進剤を含有する樹脂、及び、 1分子中に少なくとも2個の熱硬化性イミド基を有する イミド化合物から選ぶ。

【0023】また本発明の接着フィルム、すなわち、熱 硬化性樹脂が、エポキシ樹脂、フェノール樹脂及び硬化 促進剤を含有する樹脂である場合の接着フィルムは、

全テトラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテ トラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得ら れるポリイミド樹脂(A);100重量部、エポキシ樹 脂; 0. 01~200重量部、フェノール樹脂;エポキ シ樹脂100重量部に対し、2~150重量部、及び硬 化促進剤;エポキシ樹脂100重量部に対し、0.01 ~50重量部、を有機溶媒に溶解し、(2) ベースフィル ム上に塗布し、加熱する、ことにより製造され、熱硬化 性樹脂が、1分子中に少なくとも2個の熱硬化性イミド 基を有するイミド化合物である場合の接着フィルムは、 (1) 式(1) のテトラカルボン酸二無水物、の含量が、 全テトラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテ トラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得ら れるポリイミド樹脂(A);100重量部、及び1分子 中に少なくとも2個の熱硬化性イミド基を有するイミド 化合物; 0.1~200重量部、を有機溶媒に溶解し、 (2) ベースフィルム上に塗布し、加熱する、ことにより 製造される。

【0024】熱硬化性樹脂を含有させた接着フィルム は、熱時の剪断接着力が高くなる特徴がある。しかし、 熱時のピール接着力は逆に低下するので、使用目的に応 じて、熱硬化性樹脂含有又は非含有の接着フィルムと し、使い分けるとよい。なお、ここで、熱硬化性樹脂と は、加熱により3次元的網目構造を形成し、硬化する樹 脂のことである。

【0025】熱硬化性樹脂を含有させる場合、熱硬化性 樹脂の量は、ポリイミド樹脂(A)100重量部に対し 0.1~200重量部、好ましくは1~100重量部と する。200重量部を越えるとフィルム形成性が悪くな る。

【0026】熱硬化性樹脂として、エポキシ樹脂、フェ ノール樹脂及び硬化促進剤を含有する樹脂を選ぶ場合 に、用いられるエポキシ樹脂は、分子内に少なくとも2 個のエポキシ基を含むもので、硬化性や硬化物特性の点 からフェノールのグリシジルエーテル型のエポキシ樹脂 が好ましい。このような樹脂としては、ビスフェノール A、ビスフェノールAD、ビスフェノールS、ビスフェ ノール F もしくはハロゲン化ビスフェノール A とエピク ロルヒドリンの縮合物、フェノールノボラック樹脂のグ リシジルエーテル、クレゾールノボラック樹脂のグリシ 40 ジルエーテル、ビスフェノールAノボラック樹脂のグリ シジルエーテル等が挙げられる。エポキシ樹脂の量は、 ポリイミド樹脂100重量部に対し1~200重量部、\*

\*好ましくは5~100重量部で、200重量部を越える とフィルム形成性が悪くなる。

【0027】用いられるフェノール樹脂は、分子中に少 なくとも2個のフェノール性水酸基を有するもので、こ のような樹脂としては例えば、フェノールノボラック樹 脂、クレゾールノボラック樹脂、ビスフェノールAノボ ラック樹脂、ポリーp-ビニルフェノール、フェノール アラルキル樹脂等が挙げられる。フェノール樹脂の量 は、エポキシ樹脂100重量部に対して2~150重量 部、好ましくは50~120重量部で、2重量部未満も しくは150重量部を越えると硬化性が不充分となる。 【0028】硬化促進剤は、エポキシ樹脂を硬化させる ために用いられるものであれば特に制限はない。このよ うなものとしては例えば、イミダゾール類、ジシアンジ アミド誘導体、ジカルボン酸ジヒドラジド、トリフェニ ルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェ ニルボレート、2ーエチルー4ーメチルイミダゾールー テトラフェニルボレート、1,8-ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセンー7ーテトラフェニルボレー 20 ト等が用いられる。これらは、2種以上を併用してもよ い。硬化促進剤の量はエポキシ樹脂100重量部に対 し、0.01~50重量部、好ましくは0.1~20重 量部で、0.01重量部未満では、硬化性が不充分とな り、50重量部を越えると保存安定性が悪くなる。 【0029】このような接着フィルムの製造は、以下の ようにする。まずエポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリ イミド系樹脂を有機溶媒に溶解する。ここで用いられる

有機溶媒は、上記材料を均一に溶解又は混練できるもの であれば特に制限はなく、先に挙げたジメチルホルムア 30 ミド等の溶媒がある。

【0030】次いで、硬化促進剤、及び必要に応じ添加 剤を加え、先に述べた手順と同様にして、ワニスを得、 これをベースフィルム上に均一に塗布し、加熱して、接 着フィルムとする。

【0031】熱硬化性樹脂として、1分子中に少なくと も2個の熱硬化性イミド基を有するイミド化合物を使用 する場合、その化合物の例としては、オルトビスマレイ ミドベンゼン、メタビスマレイミドベンゼン、パラビス マレイミドベンゼン、1,4-ビス(p-マレイミドク ミル) ベンゼン、1, 4-ビス (m-マレイミドクミ ル) ベンゼンのほか、下記の式 (II) ~ (IV) で表され るイミド化合物等があ。

[化3] R, ...(II) C

〔式(II) 中、XはO、CH2、CF2、SO2、S、C 50 O、C (CH<sub>3</sub>) 2 又はC (CF<sub>3</sub>) 2を示し、R<sub>1</sub>、

R2、R3及びR4はそれぞれ独立に水素、低級アルキル 基、低級アルコキシ基、フッ素、塩素又は臭素を示し、 Dはエチレン性不飽和二重結合を有するジカルボン酸残\* \* 基を示す。〕 【化4】

〔式 (III) 中、YはO、CH2、CF2、SO2、S、C 10※チレン性不飽和二重結合を有するジカルボン酸残基を示 O、C (CH<sub>3</sub>) 2又はC (CF<sub>3</sub>) 2を示し、R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、 R,及びR。はそれぞれ独立に水素、低級アルキル基、低 級アルコキシ基、フッ素、塩素又は臭素を示し、Dはエ※

する。〕

10

【化5】

$$HC = CH$$

$$HC =$$

[式 (IV) 中、nは0~4の整数を示す。]

【0032】本発明で用いられるイミド化合物の量は、 ポリイミド樹脂100重量部に対して0.1~200重 量部、好ましくは1~100重量部である。200重量 部を越えるとフィルム形成性が悪くなる。

【OO33】式(II)のイミド化合物としては、例え ば、4、4-ビスマレイミドジフェニルエーテル、4, 4-ビスマレイミドジフェニルメタン、4, 4-ビスマ レイミドー3, 3'ージメチルージフェニルメタン、 4. 4ービスマレイミドジフェニルスルホン、4, 4ー ビスマレイミドジフェニルスルフィド、4,4ービスマ 30 レイミドジフェニルケトン、2,2'ービス(4ーマレ イミドフェニル) プロパン、4,4ービスマレイミドジ フェニルフルオロメタン、1, 1, 1, 3, 3, 3-へ キサフルオロー2, 2ービス(4ーマレイミドフェニ ル) プロパン、等がある。

【0034】式(III)のイミド化合物としては、例え ば、ビス〔4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニ ル] エーテル、ビス〔4-(4-マレイミドフェノキ シ) フェニル] メタン、ビス〔4-(4-マレイミドフ ェノキシ)フェニル)フルオロメタン、ビス〔4-(4 40 ーマレイミドフェノキシ)フェニル)スルホン、ビス [4-(3-マレイミドフェノキシ)フェニル]スルホ ン、ビス〔4-(4-マレイミドフェノキシ)フェニ ル] スルフィド、ビス〔4-(4-マレイミドフェノキ シ) フェニル) ケトン、2, 2-ビス〔4-(4-マレ イミドフェノキシ)フェニル]プロパン、1,1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス〔4-(4 ーマレイミドフェノキシ) フェニル] プロパン、等があ る。

【0035】これらイミド化合物の硬化を促進するた

20 め、ラジカル重合剤を使用してもよい。ラジカル重合剤 としては、アセチルシクロヘキシルスルホニルパーオキ サイド、イソブチリルパーオキサイド、ベンゾイルパー オキサイド、オクタノイルパーオキサイド、アセチルパ ーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、クメンハイド ロパーオキサイド、アゾビスイソブチロニトリル等があ る。このとき、ラジカル重合剤の使用量は、イミド化合 物100重量部に対して概ね0.01~1.0重量部が 好ましい。

【0036】この場合の接着フィルムの製造は、以下の ようにする。まず、ポリイミド樹脂(A)及び上記のイ ミド化合物をとり、先と同様にして、有機溶媒に溶解 し、必要に応じ添加剤を加え、ワニスを得、これをベー スフィルム上に均一に塗布し、加熱して、接着フィルム とする。

【0037】IC、LSI等の半導体素子と、リードフ レーム、セラミックス配線板、ガラスエポキシ配線板、 ガラスポリイミド配線板等の支持部材との間に、本発明 で得られた接着フィルムを挟み、加熱圧着すると、両者 は接着する。

[0038]

【実施例】以下、本発明を実施例により説明する。 合成例 1

温度計、攪拌機及び塩化カルシウム管を備えた500m 1の四つ口フラスコに、2,2-ビス(4-アミノフェ ノキシフェニル)プロパン41g(0.1モル)及びジ メチルアセトアミド150gをとり、攪拌した。ジアミ ンの溶解後、フラスコを氷浴中で冷却しながら、1.2 (エチレン) ビス(トリメリテート二無水物) 41g (0.1モル)を少量ずつ添加した。室温で3時間反応 50 させたのち、キシレン30gを加え、N2 ガスを吹き込

みながら150℃で加熱し、水と共にキシレンを共沸除去した。その反応液を水中に注ぎ、沈澱したポリマーを 濾過により採り、乾燥してポリイミド樹脂(A<sub>1</sub>)を得た。

## 【0039】合成例 2

温度計、攪拌機及び塩化カルシウム管を備えた500m 1の四つロフラスコに、ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェニル)スルホン43.2g(0.1モル)及びN-メチル-2-ピロリドン150gをとり、攪拌した。ジアミンの溶解後、室温で、1,4-(テトラメチ10レン)ビス(トリメリテート二無水物)43.8g(0.1モル)を加えた。5℃以下で5時間反応させ、無水酢酸20.4g(0.2モル)及びピリジン15.8g(0.2モル)を加え、1時間室温で攪拌した。この反応液を水中に注ぎ、沈澱したポリマーを濾過により採り、乾燥してポリイミド樹脂(A₂)を得た。

【0040】合成例 3

温度計、攪拌機、塩化カルシウム管を備えた500m1\*

\*の四つロフラスコに、2,2ービス(4ーアミノフェノキシフェニル)プロパン32.8g(0.08モル)、3,3′,5,5′ーテトラメチルー4,4′ージアミノジフェニルメタン5.08g(0.02モル)及びマメチルアセトアミド100gをとり、攪拌した。ジアミンの溶解後、フラスコを氷浴中で冷却しながら、1,10ー(デカメチレン)ビス(トリメリテート二無水物)41.8g(0.08モル)及びベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物6.44g(0.02モル)を少力ルボン酸二無水物6.44g(0.02モル)を少力ルボン酸二無水物6.44g(0.02モル)を少力ルボン酸二無水物6.44g(0.02モル)を添加で4時間反応させた後、無水酢酸25.5g(0.25モル)及びピリジン19.8g(0.25モル)及びピリジン19.8g(0.25モル)と添加し、2時間室温で攪拌した。その反応液を水中に注ぎ、沈澱したポリマーを濾過により採り、乾燥してポリイミ

ド樹脂 (A<sub>3</sub>)を得た。 【0041】実施例1

表 1 に示す配合表に従い、まず、ワニスを調合した。 【表 1 】

(単位:重量部)

表 1 配合表

材 料 No. 1 No. 2 No. 3 ポリイミド樹脂 Αı Αz Аз 100部 100部 100部 溶媒 300 300 300 (ジメチルアセトアミド)

【0042】このワニスを30~50 $\mu$ mの厚さにポリ ※た。フィルム形成性は、いずれも良好であった(表エステルフィルム上に塗布し、80℃で10分、つづい 30 2)。 て150℃で30分加熱し、3種類の接着フィルムを得※ 【表2】

表2 ワニスのフィルム形成性

項目	No. 1	No. 2	No. 3
・フィルム形成性	0	0	0

なお、表2(あるいは、後述の表4及び表6)において、フィルム形成性の○、×はそれぞれ下記の意味である。

○:ベトツキがなく、ポリエステルフィルムから容易に 剥がすことができる。

×:ベトツキがあり、又はフィルムが脆く、ポリエステ★

★ルフィルムから剥がすことが困難。

【0043】実施例2

40 表 3 に示す配合表に従い、No. 4 ~No. 9 の 6 種類のペースト状混合物(ただし、No. 8 は比較)を調合した。 【表 3】

(単位:重量部)

表3 配合表

材料 No. 4 5 6 7 8 9(比較) エポキシ YDCN-702 N-865 ESCN-195 N-865 YDCN-702 N-865 樹脂 50部 20部 10部 10部 7部 100部

٠	^	
ı	~	
ı	.,	

13						14	
フェノー	H-1	H-1	VH-4170	VH-4170	VH-4170	H-1	
ル樹脂	24	10	6	6	5	48	
硬化促進	2P4MHZ	TPPK	2MA-OK	TPPK	TPPK	2P4MHZ	
剤	0.5	0.4	0.1	0.5	0.7	1	_
ポリイミ	Αı	Αz	Аз	Αı	Aı	_	
ド樹脂	100	100	100	100	100	0	
溶媒	DMAA	NMP	DMF	DMF	DMF	DMAA	
	400	200	100	100	67	1000	

【0044】なお、表3において、種々の記号は下記の

意味である。

YDCH-702: 東都化成、クレゾールノボラック型エポキシ

(エポキシ当量220)

N-865:大日本インキ製、ビスフェノールノボラック型

エポキシ (エポキシ当量208)

ESCN-195:日本化薬、クレゾールノボラック型エポキシ

(エポキシ当量200)

H-1:明和化成、フェノールノボラック(OH当量106)

VH-4170: 大日本インキ、ビスフェノールAノボラック \*

表4 ワニスのフィルム形成性

#### \*(OH当量118)

DMAA: ジメチルアセトアミド

NMP : N-メチルピロリドン

DMF : ジメチルホルムアミド

【0045】このワニスを30~50µmの厚さにポリ エステルフィルム上に塗布し、80℃で10分、つづい て150℃で30分加熱し、接着フィルムを得た。フィ

20 ルム形成性は、表4に示した。

【表4】

項目	No. 4	5	6	7	8	9 (比較)
フィルム形成性	0	0	0	0	0	×

【0046】実施例3

※一スト状混合物を調合した。

表 5 に示す配合表に従い、No.9~No.13の5種類のペ※30

表 5 配合表

(単位:重量部)

BMDADPE: 4, 4'ービスマレイミドジアミノジフェニ

材料	No. 1 O	1 1	1 2	1 3	1 4
ポリイミド	A i	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A、	A :
樹脂	100部	100部	100部	100部	100部
イミド化合物	BMDADPM	BMDADPM	BMPPP	BMPPP	BMDADPE
	20	50	10	50	30
<del></del> 溶 媒	DMAA	DMAA	NMP	DMF	DMAA
その他	BPO	DCPO	BPO	CHP0	DCP0
	0.1	0.2	0.01	0.003	0.1

【0047】ただし、表5中の記号は、下記の意味であ

る。

ルメタン

シ) フェニル) プロパン

BMDADPM : 4, 4'ービスマレイミドジアミノジフェニ

DMAA: ジメチルアセトアミド

**BMPPP : 2, 2ービス (4ー (4ーマレイミドフェノキ 50 NMP : Nーメチルピロリドン** 

ルエーテル

DMP :ジメチルホルムアミド

BPO : ベンゾイルパーオキサイド

DCPO: ジクミルパーオキサイド

CHPO: クメンハイドロパーオキサイド

【0048】 ワニスを $30\sim50\mu$  mの厚さにポリエス\* 表6 ワニスのフィルム形成性

\* テルフィルム上に塗布し、80℃で10分、つづいて15 0℃で15分加熱し、接着フィルムを得た。フィルム形 成性は、表6に示した。

16

【表6】

項 目	No. 1 O	1 1	1 2	1 3	1 4	
フィルム形成性	0	0	0	0	0	

# 【0049】試験例 1

実施例1で得られた接着フィルムの剪断接着力を測定すると、表7に示す通りであった。なお、試験方法は、接着フィルムを4×4mmの大きさに切断し、これを4×4mmのシリコンチップと銀メッキ付リードフレームの※

※間に挟み、1000gの荷重をかけて、260℃、3秒間圧着させたのち、プッシュプルゲージを用いて、室温時及び350℃加熱20秒後の熱時に、剪断接着力を測定した。

【表7】

表7 接着フィルムの剪断接着力

項目		No. 1	No. 2	No. 3
剪断接着力 (kgf/ chip)	室温	12.0	11.3	10.7
(-0-) ct,	350℃	0. 3	0. 5	0.4

## 【0050】試験例 2

実施例2で得られた接着フィルムの剪断接着力を測定すると、表8に示す通りであった。なお、試験方法は、接着フィルムを4×4mmの大きさに切断し、これを4×4mmのシリコンチップと銀メッキ付リードフレームの間に挟み、50gの荷重をかけて、200℃、3分間圧 30着させたのち、プッシュプルゲージを用いて、室温時及★

★び350℃加熱20秒後の熱時に、剪断接着力を測定した。表7及び表8を比較すると、熱硬化性樹脂含有の接着フィルム(No.4~8)は、熱硬化性樹脂非含有の接着フィルム(No.1~3)よりも、350℃における剪断接着力が高いことが分かる。

【表8】

表8 接着フィルムの剪断接着力

項 目	No. 4	. 5	6	7	8	9 (比較)
剪断接着力 室 (kgf/chip)	温 10.7	12.7	10.4	12.9	11.8	—*
350	<b>℃</b> 2.1	3.2	1.7	2.0	2.2	-*

\*:フィルムが形成できなかったので、測定不可。 【0051】試験例 3

40☆ると、表9に示す通りであった。なお、試験方法は、試験例2と同様にして行った。

実施例3で得られた接着フィルムの剪断接着力を測定す☆

【表9】

## 表9 接着フィルムの剪断接着力

項目		No. 1 O	1 1	1 2	1 3	1 4	
剪断接着力 (kgf/chip)	室温	11.0	13.2	16.6	15.5	10.9	
	350℃	1.9	3.0	2.8	2.0	2.5	

IU)

【0052】試験例 4

実施例1及び実施例2で得られた接着フィルムのピール 接着力を測定すると、表10に示す通りであった。な お、ピール接着力は、接着フィルムを8×8mmの大き さに切断し、これを8×8mmのシリコンチップと銀メ\*

17

\*ッキ付リードフレームの間に挟み、1000gの荷重をかけて、300  $\mathbb{C}$ 、5 秒間圧着させたのち、250  $\mathbb{C}$ 、20 秒加熱時に測定した。

18

【表10】

表10 接着フィルムのピール接着力

項目	No. 1	2	3	4	5	6	7	8	9 (比較)
ピール接着力 (kgf/chip) 2 5		2.2	2.4	1.7	1.2	1.6	2.4	1.8	<del>*</del>

\*:フィルムが形成できなかったので、測定不可。 表10の結果から、熱硬化性樹脂非含有の接着フィルム (No.1~3)は熱硬化性樹脂含有の接着フィルム(No.4~8)よりも、250℃におけるピール接着力が ※

※高いことが分かる。

[0053]

【発明の効果】本発明の接着フィルムは、比較的低温で 行うことのできるダイボンド用接着フィルムである。

フロントページの続き

(72)発明者 宮寺 康夫

茨城県つくば市和台48番 日立化成工業株 式会社筑波開発研究所内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成11年(1999)5月18日

【公開番号】特開平7-228697

【公開日】平成7年(1995)8月29日

【年通号数】公開特許公報7-2287

【出願番号】特願平6-18496

【国際特許分類第6版】

COSG 73/10 NTF
COSL 79/08 LRC
CO9J 7/02 JHL
JKD
179/08 JGE
[FI]
COSG 73/10 NTF

COSL 73/10 NTF COSL 79/08 LRC CO9J 7/02 JHL JKD

179/08 JGE

## 【手続補正書】

【提出日】平成9年12月22日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

\*【補正内容】 【特許請求の範囲】 【請求項1】化1の式(I) 【化1】

(ただし、nは2~20の整数を示す。)で表されるテトラカルボン酸二無水物、の含量が全テトラカルボン酸二無水物の70モル%以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミド樹脂を含有してなる接着フィルム。

【請求項2】(A)請求項1記載の式(I)で表される テトラカルボン酸二無水物の含量が全テトラカルボン酸 二無水物の70モル%以上であるテトラカルボン酸二無 水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミド樹脂 および(B)熱硬化性樹脂を含有してなる接着フィル ム。

【請求項3】支持部材に請求項1又は2の接着フィルム を接着させた接着フィルム付き支持部材。

【請求項4】半導体素子を請求項1又は2の接着フィル <u>ムで支持部材に接着させてなる</u>半導体装置。